【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成21年4月23日(2009.4.23)

【公開番号】特開2006-352100(P2006-352100A)
【公開日】平成18年12月28日(2006.12.28)
【年通号数】公開・登録公報2006-051
【出願番号】特願2006-138567(P2006-138567)
【国際特許分類】
Ｈ０１Ｌ　21/02　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　27/12　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　27/08　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　21/8234　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　27/088　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　21/20　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｈ０１Ｌ　27/12　Ｂ
Ｈ０１Ｌ　27/08　３３１Ｅ
Ｈ０１Ｌ　27/08　１０２Ｄ
Ｈ０１Ｌ　21/20

【手続補正書】
【提出日】平成21年3月6日(2009.3.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
基板上に、金属を含む第１の層を形成し、
前記第１の層上に、無機材料を含む第２の層を形成し、
前記第２の層上に、薄膜トランジスタを含む第３の層を形成し、
前記第３の層上に、樹脂を含む第４の層を形成し、
レーザー光を照射することにより、少なくとも前記第１の層が露出するように、前記第２の層、前記第３の層及び前記第４の層に開口部を形成し、
前記第４の層上に、樹脂を含む第５の層を形成し、
前記基板から、前記第３の層と前記第５の層を分離することを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項２】
基板上に、第１の無機材料を含む第１の層を形成し、
前記第１の層上に、金属を含む第２の層を形成し、
前記第２の層上に、第２の無機材料を含む第３の層を形成し、
前記第３の層上に、薄膜トランジスタを含む第４の層を形成し、
前記第４の層上に、樹脂を含む第５の層を形成し、
レーザー光を照射することにより、少なくとも前記第２の層が露出するように、前記第３の層、前記第４の層及び前記第５の層に開口部を形成し、
前記第５の層上に、樹脂を含む第６の層を形成し、
前記基板から、前記第４の層と前記第６の層を分離することを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項３】
請求項１において、
前記第１の層の内部又は前記第１の層と前記第２の層の間を境界として、前記基板から、前記第３の層と前記第５の層を分離することを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項４】
請求項１において、
前記第３の層は、アンテナとして機能する導電層を有することを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項５】
請求項２において、
前記第２の層の内部又は前記第２の層と前記第３の層の間を境界として、前記基板から、前記第４の層と前記第６の層を分離することを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項６】
請求項２において、
前記第４の層は、アンテナとして機能する導電層を有することを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項７】
請求項１乃至請求項６のいずれか一項において、
前記金属として、タングステン又はモリブデンを含む層を形成することを特徴とする半導体装置の作製方法。